

Низкие динамические потери
 Малый заряд обратного восстановления
 Разветвленный управляющий электрод для
 высоких скоростей нарастания тока

Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ253-800-22

Средний прямой ток	I_{TAV}	800 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	2000 ÷ 2200 В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}	
Время выключения	t_q	20.0; 25.0; 32.0; 40.0 мкс
U_{DRM} , U_{RRM} , В	2000	2200
Класс по напряжению	20	22
T_j , °C		- 60 ÷ 125

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	А	800 1180	$T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=55$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	А	1255	$T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	17.0 19.5	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			18.0 21.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
I^2t	Защитный фактор	$A^2\cdot 10^3$	1445 1900	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			1340 1830	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	2000÷2200	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	2100÷2300	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\ max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	А	8	$T_j = T_{j\ max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	А/мкс	2000	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$; Импульс управления: $I_G = I_{FGM}$; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 1$ А/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	- 60 ÷ 125	
T_j	Температура р-п перехода	°C	- 60 ÷ 125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	24.0÷28.0	
a	Ускорение	м/с ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

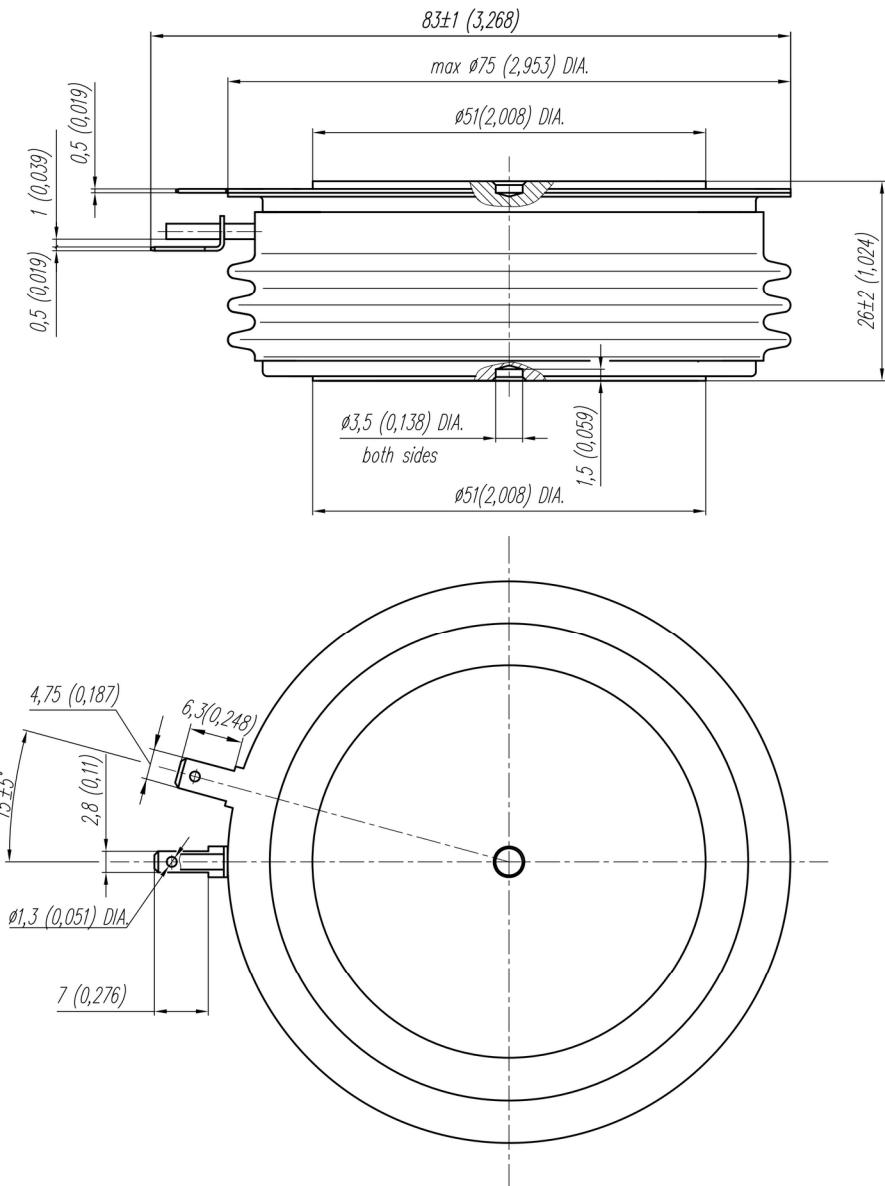
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии			
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.50
$U_{T(to)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.40
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.49
I_H	Ток удержания, макс	мА	500
			$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики			
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	150
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ¹⁾ , мин	В/мкс	1000
			$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
			$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления								
U _{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс		B	4.00 2.50 2.00	T _j =T _j min T _j =25 °C T _j =T _j max			
I _{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс		mA	500 300 200	T _j =T _j min T _j =25 °C T _j =T _j max			
U _{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин		B	0.25	T _j =T _j max; U _D =0.67U _{DRM} ;			
I _{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин		mA	10.00	Постоянный ток управления			
Динамические характеристики								
t _{gd}	Время задержки включения		мкс	2.5	T _j =25 °C; V _D =0.4V _{DRM} ; I _{TM} =I _{TAV} ; Gate pulse: I _G =I _{FGM} ; V _G =20 V; t _{GP} =50 μs; di _G /dt=1 A/μs			
t _q	Время выключения ²⁾ , макс		мкс	20.0; 25.0; 32.0; 40.0	dv _D /dt=50 В/мкс;			
				25.0; 32.0; 40.0; 50.0	dv _D /dt=200 В/мкс;			
Q _{rr}	Заряд обратного восстановления, макс		мкКл	400	T _j =T _j max; I _{TM} =I _{TAV} ;			
t _{rr}	Время обратного восстановления, макс		мкс	5.0	di _R /dt=-50 A/мкс ; U _R =100 В			
I _{rrM}	Ток обратного восстановления, макс		A	165	U _R =100 В			
Тепловые характеристики								
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт		0.0210	Двухстороннее охлаждение			
R _{thjc-A}				0.0462	Охлаждение со стороны анода			
R _{thjc-K}				0.0378	Охлаждение со стороны катода			
R _{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.004	Постоянный ток				
Механические характеристики								
w	Масса, тип		г	550				
D _s	Длина пути тока утечки по поверхности		мм (дюйм)	29.47 (1.160)				
D _a	Длина пути тока утечки по воздуху		мм (дюйм)	17.50 (0.689)				
ПРИМЕЧАНИЕ			МАРКИРОВКА					
1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии			ТБИ	253	800			
			1	2	3			
			4	5	6			
			7					
Обозначение группы			A2					
(dv _D /dt) _{crit} , В/мкс			1000					
2) Время выключения (dv _D /dt=50 В/мкс)			1.	Быстродействующий импульсный тиристор				
			2.	Конструктивное исполнение				
			3.	Средний ток в открытом состоянии, А				
			4.	Класс по напряжению				
			5.	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии				
			6.	Группа по времени выключения (dv _D /dt=50 В/мкс)				
			7.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т				

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: Т.D2



Все размеры в миллиметрах (дюймах)